

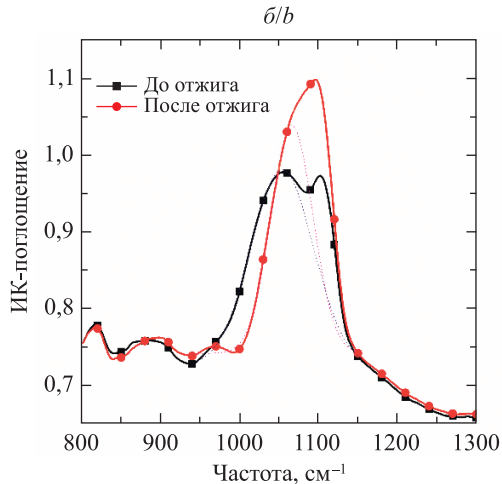
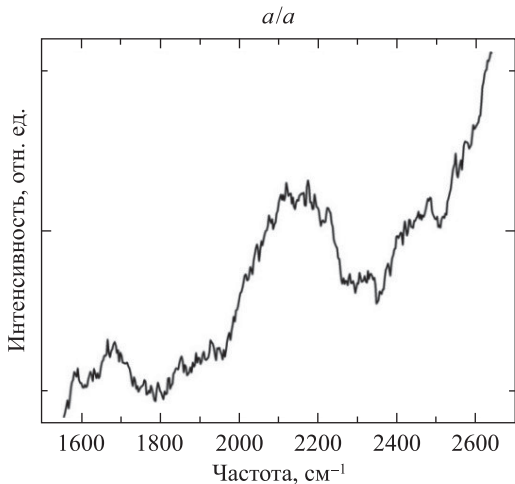


Рис. 2. Спектр КРС в области колебаний связей Si—H (*a*)
и спектры ИК-поглощения в области колебаний связей Si—O до и после отжига (*б*)
для структуры SiO₂/Si, полученной методом плазмохимического осаждения

Fig. 2. RS spectrum in the range of Si—H vibrations (*a*) and IR absorbance spectra in the range of Si—O vibrations before and after annealing (*b*) for the SiO₂/Si structure formed by plasma-enhanced chemical vapor deposition